



**SISTEMI DI METROLOGIA 3D**

**RIEPILOGO PARAMETRI TECNICI**

Il presente documento riassume le specifiche dell’apparecchiatura descritte nel Capitolato Speciale - parte tecnica.

Al fine di consentire alla Commissione di gara la valutazione dell’offerta tecnica, il Concorrente dovrà compilare le sottostanti tabelle, mediante indicazione dei valori offerti e il riferimento al relativo paragrafo della relazione tecnica.

(Riferimento: Capitolato speciale parte tecnica e Relazione tecnica dell’Offerente)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| criteri di valutazione | Rif. paragrafo capitolato | Descrizione | Valore offerto | Rif. paragrafoofferta tecnica |
| **sistema di alloggiamento wafer** | 3.1.1 | possibilità chuck per alloggiamento di frammenti di wafer per misura di misure di film sottili e spessi |  |  |
| 3.1.2 | intercambiabilità di chuck 6" e 8 " in tempi brevi (meno di 5 minuti) |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Telecamera** | 3.2.1 | risoluzione superiore a 2Mp |  |  |
| 3.2.2 | ottica aggiuntiva per avere un field of view di 1x1 mm^2 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **misura variazione spessore wafer o stack di wafers (total thickness variation)** | 3.3.1 | scansione di un wafer 6”, con campionamento 1x1mm2 in un tempo minore a 10 min |  |  |
| 3.3.2 | Accuratezza della misura di spessore minore allo 0.5% nel range di misura 100-2000 um |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **misura di film spessi** | 3.4.1 | misura spessori minimo (bonding adhesive o equivalente, n=1.5) < 4 micron |  |  |
| 3.4.2 | risoluzione laterale in x, y< 30 micron |  |  |
| 3.4.3 | deve raggiungere una risoluzione nella misura di spessore minore o uguale a 50 nm nel range 4-10 micron |  |  |
| 3.4.4 | deve raggiungere una risoluzione nella misura di spessore minore a 300 nm nel range 10-700 micron |  |  |
| 3.4.5 | scansione di un wafer 6”, con campionamento 1x1mm2 in un tempo minore a 10 min |  |  |
| 3.4.6 | sw che permetta di inserire per le misure interferometriche l'indice di rifrazione manualmente di materiali non custom |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **interferometro** | 3.5.1 | lampada UV aggiuntiva per misura di spessore SiO2 < a 60 nm |  |  |
| 3.5.2 | deve poter raggiungere un’accuratezza in z < a 2% per spessori maggiori di 60 nm |  |  |
| 3.5.3 | deve poter raggiungere una risoluzione laterale in x,y < di 30 micron |  |  |
| 3.5.4 | sw che permetta di inserire per le misure interferometriche l'indice di rifrazione manualmente di materiali non custom |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **sw elaborazione dati/sw elaborazione dati** | 3.6.1 | sw con possibilità di determinazioni di tipo step height |  |  |
| 3.6.2 | sw con allineamento automatico sui marker |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **caratteristiche migliorative** | 3.7.1 | possibilità di upgradare il sistema con sensore per la misura di roughness, con risoluzione in z minore o uguale a 1nm e risoluzione laterale minore di 1 micron. |  |  |
| 3.2.2 | garanzia aggiuntiva strumento  |  |  |
|
| 3.7.3 | 1 visita annuale di check macchina post garanzia |  |  |